







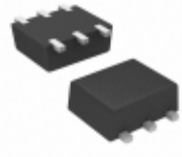
	<h2>SI1058X-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1058X-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V SC89</p> <p>Datenblätter:  SI1058X-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2063 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1058X-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V SC89
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2063 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 236mW (Ta) Surface Mount SC-89-6
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Supplier Device-Gehäuse	SC-89-6
Verlustleistung (max)	236mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	91 mOhm @ 1.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.55V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.9nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	380pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)




SI1058X-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1058X-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1058X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1058X-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1060-A-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 36-WFQFN</p>	 <p>SI1060-A-GMR Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 36-WFQFN</p>	 <p>SI1058X-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 1.3A SOT563F</p>	 <p>SI1061-A-GMR Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 36-WFQFN</p>
 <p>SI1056X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V SC-89-6</p>	 <p>SI1061-A-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 36-WFQFN</p>	 <p>SI1062-A-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 36-WFQFN</p>	 <p>SI1058X-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 1.3A SOT563F</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited